

CFRP加工の 温間成形用電源

スイッチング効率2倍

空冷でインフラ費用を節減

表皮効果による高速加熱



もっと少ないコストで
もっと大きなエネルギーを得られる
電源を目指しました

最新の低損失デバイスSiC素子を積極的にとり入れた新しい高周波電源です。

短時間成形を可能とするため、高周波通電加熱を用いて成形金型内での急加熱急冷を実現しました。

シミュレーションを基に高い均熱制御性を可能とします。

冷却水が不要になり(インバータ部)、ユーティリティコストを節減(従来比30%減)します。

➤ 仕様

定格出力	10~200kW
周波数	1~250kHz (共振周波数に自動追従)
出力制御範囲	0~100% (連続)



SiC通電加熱用高周波電源
MEI-Series

SiC汎用型高周波電源
HPI-Series

➤ 従来仕様との比較

	IGBT	MOSFET (Si)	MOSFET (SiC)
周波数	~30kHz	~400kHz	~400kHz
耐電圧	1200V	600V	1200V
損失 (抵抗)	大	大	小
特徴	低価格	高い周波数に対応、並列運転が可能	高い周波数に対応、低損失